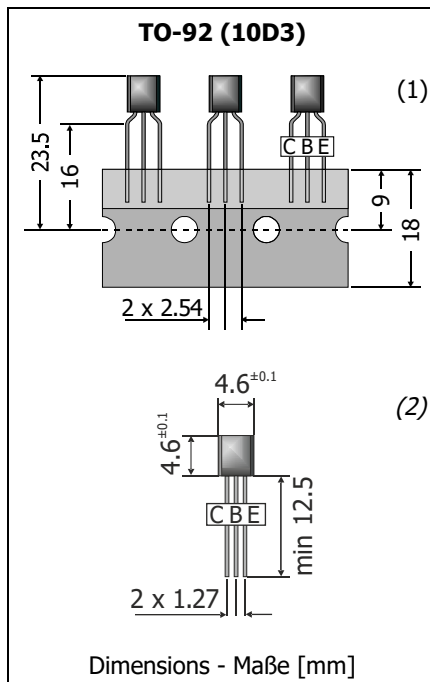


**BC327 ... BC328**  
**General Purpose PNP Transistors**  
**Universal-PNP-Transistoren**

$I_C = -800 \text{ mA}$        $V_{CE0} = -25 \dots -45 \text{ V}$   
 $h_{FE} \sim 160/250/400$        $P_{tot} = 625 \text{ mW}$   
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

Version 2018-02-02

**Typical Applications**

Signal processing,  
 Switching, Amplification  
 Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

General Purpose  
 Three current gain groups  
 Compliant to RoHS, REACH,  
 Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

- (1) Taped in ammo pack (Raster 2.54) 4000  
 (2) *On request: in bulk* (Raster 1.27, suffix "BK") 5000

Weight approx. 0.18 g

Case material UL 94V-0

Solder &amp; assembly conditions 260°C/10s



4000

5000

0.18 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL N/A

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung,  
 Schalten, Verstärken  
 Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Universell anwendbar  
 Drei Stromverstärkungsklassen  
 Konform zu RoHS, REACH,  
 Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

- (1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)  
 (2) *Auf Anfrage: Schüttgut* (Raster 1.27, Suffix "BK")

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

Current gain groups Stromverstärkungsgruppen		Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren
BC327-16 BC327-25 BC327-40	BC328-16 BC328-25 BC328-40	BC337 ... BC338

**Maximum ratings <sup>2)</sup>****Grenzwerte <sup>2)</sup>**

			BC327	BC328
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	E-B short	- $V_{CES}$	50 V	30 V
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- $V_{CEO}$	45 V	25 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- $V_{EBO}$	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	625 mW <sup>3)</sup>	
Collector current – Kollektorstrom	DC	- $I_C$	800 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- $I_{CM}$	1 A	
Base current – Basisstrom		- $I_B$	100 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	-55...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	-55...+150°C	

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified –  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , wenn nicht anders angegeben

3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case  
 Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics**
**Kennwerte**

				$T_j = 25^\circ\text{C}$	<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup>							
- $V_{CE} = 1\text{ V}$	- $I_C = 100\text{ mA}$	Group -16	$h_{FE}$	100	160	250	
		Group -25		160	250	400	
		Group -40		250	400	630	
	- $I_C = 300\text{ mA}$	Group -16	$h_{FE}$	60	130	–	
		Group -25		100	200	–	
		Group -40		170	320	–	
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. <sup>1)</sup>							
- $I_C = 500\text{ mA}$	- $I_B = 50\text{ mA}$		- $V_{CEsat}$	–	–	0.7 V	
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung <sup>1)</sup>							
- $V_{CE} = 1\text{ V}$	- $I_C = 300\text{ mA}$		- $V_{BE}$	–	–	1.2 V	
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Emitter-Reststrom							
- $V_{CE} = 45\text{ V}$	B-E short	BC327 BC328	- $I_{CES}$	–	2 nA	100 nA	
- $V_{CE} = 25\text{ V}$							
- $V_{CE} = 45\text{ V}$	B-E short	BC327 BC328	- $I_{CES}$	–	–	10 $\mu\text{A}$	
- $V_{CE} = 25\text{ V}$							$T_j = 125^\circ\text{C}$
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz							
- $V_{CE} = 5\text{ V}$ ,	- $I_C = 10\text{ mA}$ ,	- $f = 50\text{ MHz}$	$f_T$	–	100 MHz	–	
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität							
- $V_{CB} = 10\text{ V}$ ,	$I_E = I_E = 0$ ,	$f = 1\text{ MHz}$	$C_{CBO}$	–	12 pF	–	
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			$R_{thA}$	< 200 K/W <sup>2)</sup>			

**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)

**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

<sup>1</sup> Tested with pulses  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

<sup>2</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):*

*Click to view products by [Diodec manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MJ15024/WS](#) [MJ15025/WS](#) [BC546/116](#) [BC556/FSC](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [HN7G01FU-A\(T5L,F,T](#)  
[NJVMJD148T4G](#) [NSVMMBT6520LT1G](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE2353](#) [NTE316](#) [IMX9T110](#) [NTE63](#) [NTE65](#)  
[C4460](#) [SBC846BLT3G](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA1727TLP](#) [2SA2126-E](#) [2SB1202T-TL-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-](#)  
[TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2SB1202S-TL-E](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC4618TLN](#) [2SC5490A-TL-H](#)  
[2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [BC557B](#) [TTC012\(Q\)](#) [BULD128DT4](#) [JANTX2N3810](#)  
[Jantx2N5416](#) [US6T6TR](#) [KSF350](#) [068071B](#)